



纳米级tio²加入zno压敏电阻配方中的方法

文献类型: 专利

;;;

作者 冯士芬;季幼章

发表日期 2000-12-06

专利国别 中国

专利号 cn1273424

专利类型 发明

权利人 中国科学院等离子体物理研究所

是否PCT专利 是

学科主题 新能源材料与工程

公开日期 2009-10-30 ; 2009-10-30

申请日期 1999

专利申请号 cn99120639

源URL [http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/1452]

专题 合肥物质科学研究院_中科院等离子体物理研究所

推荐引用方式 冯士芬,季幼章. 纳米级tio²加入zno压敏电阻配方中的方法, 纳米级tio²加入zno压敏电阻配方中的方法, 纳米级tio²加入zno压敏电阻配方中的方法. cn1273424. 2000-12-06.

GB/T 7714 冯士芬,季幼章. 纳米级tio²加入zno压敏电阻配方中的方法, 纳米级tio²加入zno压敏电阻配方中的方法, 纳米级tio²加入zno压敏电阻配方中的方法. cn1273424. 2000-12-06.

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
563	142	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。